

## 供媒體即時發佈

### 投資關係者：

Ed Lockwood

投資者關係資深總監

(408) 875-9529

ed.lockwood@kla-tencor.com

### 媒體關係者：

Meggan Powers

企業宣傳資深總監

(408) 875-8733

meggan.powers@kla-tencor.com

## KLA-Tencor 推出 PROLITH™ X3.1 模擬光電腦模擬軟體，以極具成本效益的方式解決了 EUV 研究和雙次成像微影的挑戰

- 讓微影研究的深度和廣度得以延伸
- 有助於降低微影製程單元的營運費用
- 縮短確定有效微影解決方案所需的時間

【加州 MILPITAS 2010 年 2 月 18 日訊】今天，專為半導體和相關產業提供製程控制及良率管理解決方案的全球領先供應商 KLA-Tencor Corporation (納斯達克股票代碼: KLAC) 推出了他們最新一代的 PROLITH 模擬光電腦模擬軟體。PROLITH X3.1 讓處於前瞻地位的晶片廠商、研發機構及設備製造商能迅速且極具成本效益地解決超紫外線 (EUV) 和雙次成像微影 (DPL) 製程中的挑戰性問題，包括與晶圓堆疊不平坦有關的邊緣粗糙度 (LER) 和成像問題。使用 PROLITH X3.1 微影模擬軟體能簡化他們的研發，節省寶貴的微影單位資源，並加速產品的開發。

KLA-Tencor 的製程控制資訊部副總裁兼區域總經理 Ed Charrier 表示：「在評估 2Xnm 及未來更先進設計的多項微影技術方面，研發人員面臨著一項異常複雜的任務。他們必須解製程設計前後如何影響在晶圓上的成像，包括光罩設計、掃描曝光機設定、晶圓堆疊不平坦和光阻成份的差異等影響。PROLITH X3.1 並不實際曝光測試晶圓，而是模擬成像結果，利用基本物理學原理來協助研發人員研究和最佳化微影製程。新的 X3.1 版 EUV 和 LER 功能只需數分鐘就能產生精準結果，使其可以大幅縮短產品開發時間。此外，這項策略還能降低掃描曝光機、track 和 CD-SEM 機台轉至運行可行性實驗的時間，釋出 EUV 技術以便進行整合與測試，或釋出微影技術以增加生產運行。」

PROLITH X3.1 包括若干功能，其設計目的是讓研發人員能經濟高效地研究不同的微影技術：

- 它是市場上是第一款考慮光的量子行為和光阻中的離散反應分子的隨機型(或然率)產品，能協助研發人員：
  - 以數分鐘的運行時間精準模擬 LER，讓在實際的晶圓廠中研究各種製程條件對 LER 的影響成為現實；
  - 對影像刻印的可重複性以及對良率的影響進行研究；
  - 對線和接觸孔 CD 的均勻性進行預測；
  - 判定可用的製程容許量；以及
  - 測試不同的光阻反應物載入級如何影響成像(例如製程容許量、CD 控制、缺陷級)，從而讓材料製造商能以顯著降低的成本探索光阻配方；
- 市場上第一款模擬 EUV 光電子微影製程結果的產品；

- 直覺的晶圓堆疊平坦設定和改善後的晶圓堆疊平坦模組允許迅速、方便地對雙次和單次成像非平坦微影層積和諸如 FinFET 等次世代非平坦元件進行評估；
- 超過 60 個高精度、經過校準的光阻模型，可供立即使用；
- 在一台 32 位元個人電腦上執行的直觀介面能  提供迅速、精準的微影模組，而無需升級電腦或使用超級電腦；
- 可以升級領先業界的 PROLITH 平台，提供擴展能力，以保護研發人員的現有資本投資。

PROLITH X3.1 是 KLA-Tencor 因應先進微影挑戰的最新廣泛工具產品。關於 PROLITH X3.1  擬  光電腦模擬軟體如何能  協助研發人員經濟高效地評估先進微影技術，請參觀產品網頁：<http://www.kla-tencor.com/lithography-modeling/chip-prolith.html>。

#### **關於 KLA-Tencor：**

KLA-Tencor Corporation (納斯達克股票代碼：KLAC) 是製程控制與良率管理解決方案的領先提供商，它與全球客戶  合作，開發先進的檢測與度量技術。這些技術為半導體、資料儲存、化合物半導體、光電及其他相關奈米電子產業提供服務。公司擁有廣泛的業界標準產品系列及世界一流的工程師與科學家團隊，三十餘年來為客戶  努力打造優秀的解決方案。KLA-Tencor 的總部設在美國加利福尼亞州 Milpitas，並在全球各地設有專屬的客戶  營運與服務中心。如需更多資訊，請參觀網站 [www.kla-tencor.com](http://www.kla-tencor.com)。(KLAC-P)

#### **前瞻性聲明：**

本新聞稿中除歷史事實以外的聲明，例如關於向晶片上的更小臨界線寬的預期技術轉移，包括市場對此類轉移的採納度和此類更小線寬的相關挑戰；諸如 EUV 微影和 DPL 等先進微影技術的預期使用；諸如 LER、晶圓堆疊平坦和影像刻印的可重複性等先進微影的相關預期問題；PROLITH 應對這些預期轉移相關挑戰的能力；PROLITH 的預期效能；以及 PROLITH 軟體使用者可實現的預期受益等陳述，均為前瞻性聲明，並受到《1995 年美國私人證券訴訟改革法案》(Private Securities Litigation Reform Act of 1995) 規定的「安全港」(Safe Harbor) 條款的制約。這些前瞻性聲明基於目前資訊及預期，且包含諸多風險與不確定性。由於各種因素，包括延遲採用新技術（無論是由於成本或效能問題抑或其他問題）或影響我們產品實現或使用的意外技術挑戰或限制，實際結果可能與此類聲明中的預計結果實質不同。

###